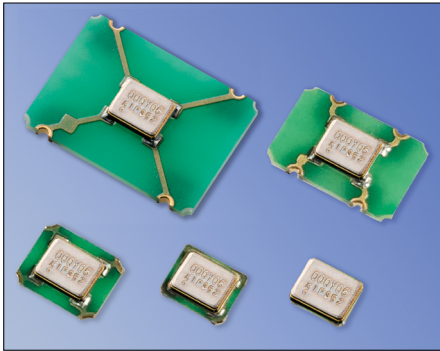




### Clock Z系列

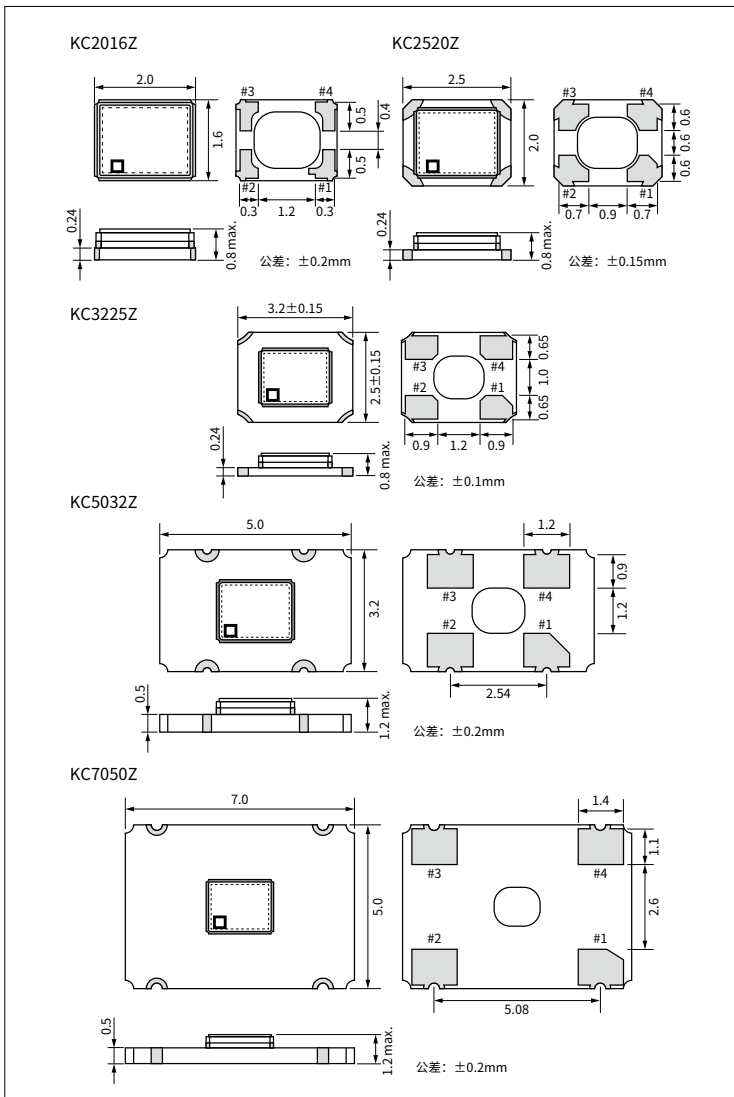
CMOS/ 1.8V、2.5V、3.3V/ 2.0×1.6、2.5×2.0、3.2×2.5、5.0×3.2、7.0×5.0mm



RoHS指令对应产品

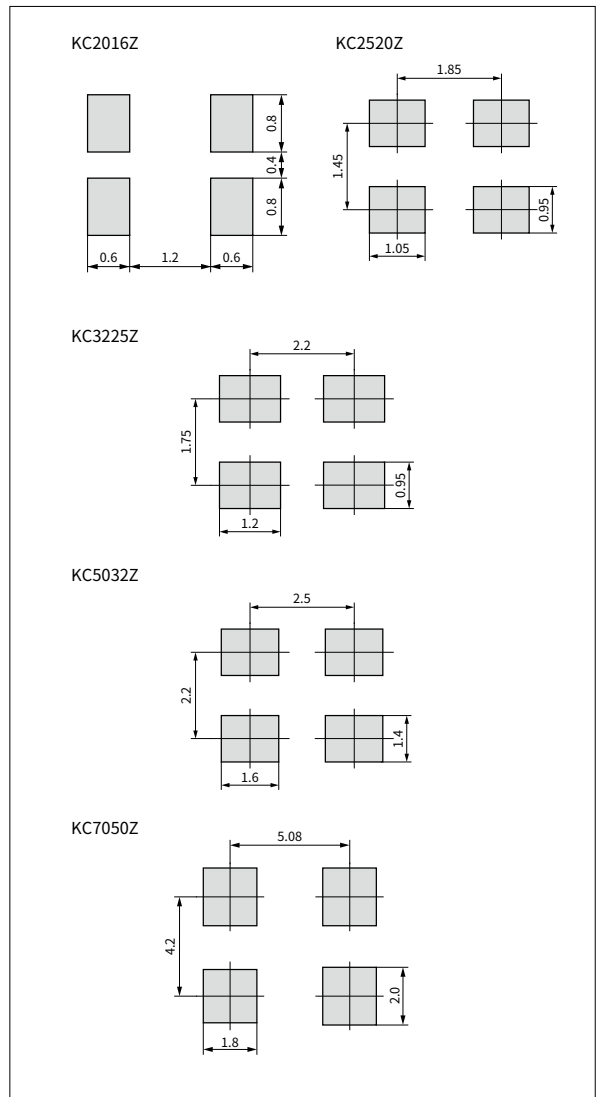
### 外形尺寸

(单位: mm)



### 推荐焊盘图案

(单位: mm)



时钟晶体振荡器

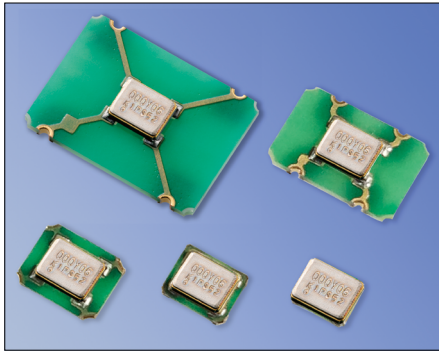
焊盘布局	
#1	Stand-by Function
#2	Case GND
#3	Output
#4	Vcc

Stand-by Function	
Pad1	Pad3 (Output)
Open	Active
"H" Level	Active
"L" Level	High Z (振荡停止)



Clock Z系列“Y”类型(低抖动类型)

CMOS/ 1.8V、2.5V、3.3V/ 2.0×1.6、2.5×2.0、3.2×2.5、5.0×3.2、7.0×5.0mm



RoHS指令对应产品

■特点

- 可对应频率 24~72MHz
- CMOS输出
- 低抖动特性
- 可对应高温(125°C)

■用途

- 消费类电子产品、网络、工业设备、娱乐

■频率容差(Overall)

代号	容差 × 10 <sup>-6</sup>	工作温度范围 (°C)	备注
S	± 30	-10 ~ +70	其他稳定度, 敬请咨询。
U	± 25		
W	± 20		
G	± 50	-40 ~ +85	
H	± 30		
J	± 25		
K	± 20	-40 ~ +105	
6	± 50		
5	± 30		
X	± 100	-40 ~ +125	
Z	± 50		

■型号表示方法

KC □□□□ Z 25.0000 C 1 □ Y 00  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①系列名称

KC2016Z	2016型号	KC2520Z	2520型号
KC3225Z	3225型号	KC5032Z	5032型号
KC7050Z	7050型号		

②输出频率(25.0000: 25MHz)

③输出形式(C: CMOS)

④电源电压(1: 可以用于这些规格 1.8V/ 2.5V/ 3.3V)

⑤频率容差(参见左表)

⑥对称/INH功能

Y	45/ 55%
---	---------

⑦个别规格(产品目录以00标示)

包装方式 载带包装

KC7050Z/ KC5032Z	1000个/卷盘
KC3225Z/ KC2520Z/ KC2016Z	2000个/卷盘

■规格

项 目	记 号	条 件	Min.	Max.	单 位	
输出频率范围	f <sub>o</sub>		输出频率范围, 敬请咨询。		MHz	
频率容差	f <sub>tol</sub>	起始偏差、工作温度范围内的温度特性、电源电压变化、负载容量变化、长期变化(1年@25°C)、包括振动和冲击	参见频率容差表			
储存温度范围	T <sub>stg</sub>		-55	150	°C	
工作温度范围	T <sub>use</sub>		参见频率容差表			
最大的额定电压	—		-0.3	4.5	V	
电源电压	V <sub>cc</sub>		1.71	3.63	V	
电流消耗 (NoLoad/ 1.71≤V <sub>cc</sub> ≤2.25)	I <sub>cc</sub>	24≤f <sub>o</sub> <30MHz	—	2.7	mA	
		30≤f <sub>o</sub> <50MHz	—	3.3		
		50≤f <sub>o</sub> ≤60MHz	—	3.7		
		60<f <sub>o</sub> <72MHz	—	4		
电流消耗 (NoLoad/ 2.25<V <sub>cc</sub> ≤2.8)	I <sub>cc</sub>	24≤f <sub>o</sub> <30MHz	—	3.5		
		30≤f <sub>o</sub> <50MHz	—	4		
		50≤f <sub>o</sub> ≤60MHz	—	4.3		
		60<f <sub>o</sub> <72MHz	—	4.8		
电流消耗 (NoLoad/ 2.8<V <sub>cc</sub> ≤3.63)	I <sub>cc</sub>	24≤f <sub>o</sub> <30MHz	—	4		
		30≤f <sub>o</sub> <50MHz	—	5		
		50≤f <sub>o</sub> ≤60MHz	—	5.5		
		60<f <sub>o</sub> <72MHz	—	6		
待机时的电流消耗	I <sub>std</sub>		—	5	μA	
波形对称	SYM	@50% V <sub>cc</sub>	24≤f <sub>o</sub> ≤40MHz	40	55	%
			40<f <sub>o</sub> ≤72MHz	45	55	
上升/下降时间 (20%~80% 输出电平)	Tr/ Tf	Loaded/ 1.71≤V <sub>cc</sub> ≤2.25	—	4	ns	
		Loaded/ 2.25<V <sub>cc</sub> ≤2.8	—	3.2		
		Loaded/ 2.8<V <sub>cc</sub> ≤3.63	—	2.7		
L电平输出电压	V <sub>oL</sub>	I <sub>oL</sub> = 5mA	—	10% V <sub>cc</sub>	V	
H电平输出电压	V <sub>oH</sub>	I <sub>oH</sub> = -5mA	90% V <sub>cc</sub>	—	V	
输出负载条件(CMOS)	L_CMOS		—	15	pF	
L电平输入电压	V <sub>iL</sub>		—	30% V <sub>cc</sub>	V	
H电平输入电压	V <sub>iH</sub>		70% V <sub>cc</sub>	—	V	
禁用时间	t <sub>dis</sub>		—	200	ns	
启用时间	t <sub>ena</sub>		—	10	ms	
振荡启动时间	t <sub>str</sub>	最小动作电压为0sec.	—	10	ms	
1 Sigma Jitter Peak to Peak Jitter	J <sub>Sigma</sub>		—	5	ps	
	J <sub>PK_PK</sub>	使用Wavecrest SIA-3000测量	—	50		
Phase Jitter	—	@50MHz V <sub>cc</sub> = 3.3V	BW: 12kHz~20MHz	1	ps	

最大负载时, 没有指定条件的电气特性为在工作温度范围内。